

apophasis / December 07, 2011 02:04PM

[\[電子元件\] 我薄膜電晶體技術 國際矚目](#)

[電子元件] 我薄膜電晶體技術 國際矚目 ([英文版](#))

《中時電子報》(2011/12/07) 英特爾搶先量產廿二奈米半導體元件後，各國全力投入更前瞻的十奈米元件技術。我國國家奈米元件實驗室突破現有半導體元件矽基材缺陷，利用純鍺研製電晶體，成功把電晶體運行速度提升二到四倍，為我國半導體技術邁向十奈米開創新局。

這項研究成果於七日在美國華盛頓舉辦的「國際電子元件會議」公開發表，被大會選為重點宣傳論文。此外，我國研究團隊獨創發明「銅銦鎳硒」薄膜電晶體技術，利用被廣泛用來製作太陽能電池的「銅銦鎳硒」薄膜，研製電晶體，成功研發出「自供電力線路模組的矽基太陽能元件」，在這項電子元件領域最重要國際研討會豔驚四座，被選為重點宣傳論文。

奈米元件實驗室副主任吳文發表示，新材料和節能科技的導入，是半導體元件邁向十奈米技術、提升效能和晶片微小化的重要關鍵。我國研究團隊這次發表的四篇論文，引起國際重視，認為是進入十奈米元件的重要技術選項。

資訊來源：

[中時電子報 2011/12/07](#)
